

Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Ишуткина Сергея Владимировича

«Разработка технологии и создание монолитного GaAs СВЧ малошумящего усилителя с металлизацией на основе пленок Al и Cu» по специальности 01.04.04 – Физическая электроника на соискание учёной степени кандидата технических наук.

Фамилия, имя, отчество	Айзенштат Геннадий Исаакович
Гражданство	Российская Федерация
Учёная степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор технических наук (01.04.10 – Физика полупроводников)
Учёное звание (по кафедре, специальности)	
Место работы	
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты организации	634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская 99а, http://www.niipp.ru , (3822) 288-288, niipp@niipp.ru
Полное наименование организации в соответствии с уставом	АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
Наименование подразделения	Лаборатория 41
Должность	Начальник лаборатории

Публикации по специальности 01.04.04 – Физическая электроника (за последние 5 лет)

1. Ющенко А.Ю., Айзенштат Г.И., Монастырев Е.А., Божков В.Г., Иващенко А.И., Преображенский В.В. Монолитная интегральная схема мощного переключателя прием-передача с защитой приемного канала для X-диапазона частот на основе рin-диодов // Изв. вузов. Физика. – 2012. – № 9/2. – С. 287-289.
2. Айзенштат Г.И., Ющенко А.Ю., Божков В.Г., Иващенко А.И. РНЕМТ-технология создания монолитных интегральных схем КВЧ-диапазона с проектной нормой от 100 нм // Изв. вузов. Физика. – 2012. – № 8/2. – С. 93-94.
3. Ющенко А.Ю., Айзенштат Г.И., Монастырев Е.А., Божков В.Г., Иващенко А.И. Пассивные МИС для создания СВЧ усилителей мощности на основе дискретных GaN-транзисторов // Изв. вузов. Физика. – 2012. – № 8/2. – С. 130-132.
4. Ющенко А.Ю., Айзенштат Г.И., Божков В.Г., Иващенко А.И. Монолитная интегральная схема двойного балансного смесителя для К-, КА-диапазонов частот на основе диодов Шоттки вертикальной конструкции // Изв. вузов. Физика. – 2012. – № 8/2. – С. 140-141.
5. Айзенштат Г.И., Ющенко А.Ю., Божков В.Г. Переходные процессы в СВЧ-rin-диодах на арсениде галлия // Изв. вузов. Физика. – 2014. – № 12. – С. 14-19.
6. Айзенштат Г.И., Ющенко А.Ю. Прямое сопротивление потерь в СВЧ rin-диодах на арсениде галлия // Электронная промышленность. – 2014. – №1. – С. 45-55.
7. Ющенко А.Ю., Айзенштат Г.И., Монастырев Е.А., Божков В.Г., Иващенко А.И. Результаты ОАО «НИИПП» в области разработки GaAs СВЧ МИС на основе rin-диодов // Электронная промышленность. – 2014. – №1. – С. 65-75.

8. Айзенштат Г.И., Ющенко А.Ю. Метод определения амбиполярной диффузионной длины и времени жизни носителей в р-і-п-диодах на арсениде галлия // Приборы и техника эксперимента. – 2015. – №2. – С. 118-121.
9. Ющенко А.Ю., Айзенштат Г.И., Пласкеев А.А., Безрук А.В., Иващенко А.И., Фролова У.М., Федотова Ф.И. Контактное устройство для зондовых измерений СВЧ нитридгаллиевых усилителей в импульсном режиме // Электронная техника, сер.1, СВЧ-техника. – 2015. – вып.1(534). – С. 40-45.

Директор по научной работе АО «НИИПП»

Е.А. Монастырев

Официальный оппонент, д.т.н

Г.И. Айзенштат

«14» // _____ 2016 г.

(Handwritten signature in blue ink)
(Handwritten initials "Г.И." in blue ink)
М.П.

